

Information



D 817 A, D 817 B, D 817 W,
D 817 G

1/86

Herstellerland: UdSSR

Übersetzung, bearb.

Allgemeines

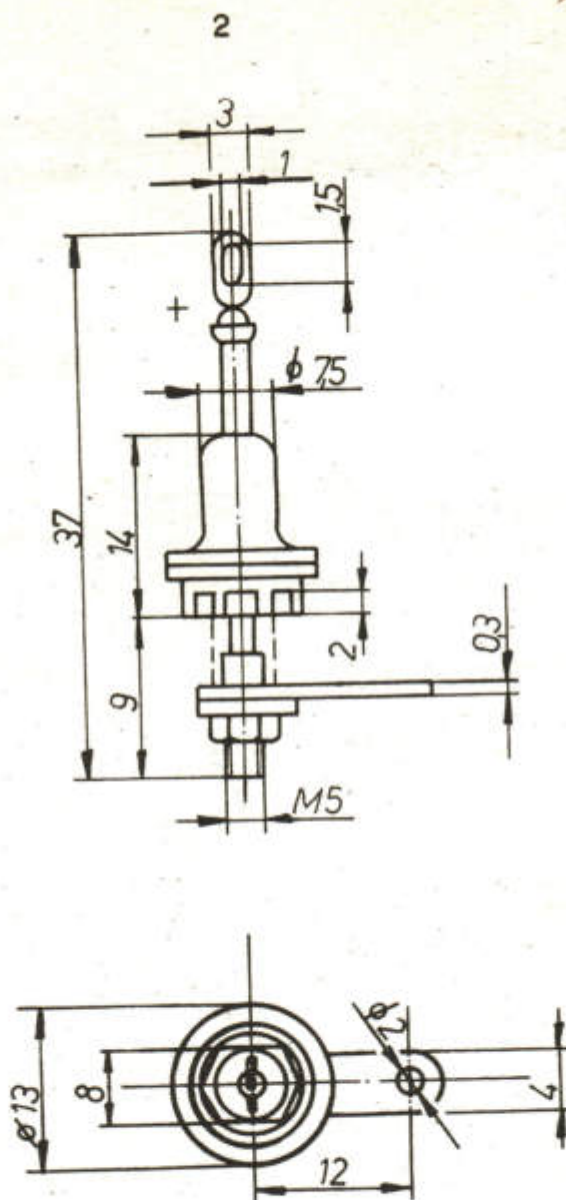
Die Silizium-Z-Dioden D 817 A - D 817 G sind für den Einsatz in Spannungs- und Stromstabilisatoren, in Impulsbegrenzungsschaltungen und als Bezugsspannungsquellen vorgesehen.

Sie sind in einem Metall-Glas-Gehäuse untergebracht.

Die Masse einer Z-Diode beträgt maximal 6 g.

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur $t_{\text{amb}} = -60 \text{ bis } +100 \text{ }^{\circ}\text{C}.$



Grenzwerte

Kenngrößen	Kurz- zeichen	W e r t e				Bedingungen	
		D817A	D817B	D817W	D817G		
maximaler Z-Strom	I_{Zmax}	90	75	60	50	mA	$t_{case} = -60$
		35	30	25	25		$\dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
		35	30	25	25		$t_{case} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$
minimaler Z-Strom	I_{Zmin}	5	5	5	5	mA	$t_{case} = -60$
							$\dots +100\text{ }^{\circ}\text{C}$
Gesamtver- lust- leistung	P_{tot}	5	5	5	5	W	$t_{case} = -60$
							$\dots +70\text{ }^{\circ}\text{C}$
		2	2	2	2		$t_{case} = 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

Elektrische Kennwerte

Kenngrößen	Kurz- zeichen	W e r t e				Bedingungen
		D817A	D817B	D817W	D817G	
Z-Spannung	U_Z	56	68	82	100 V	$I_Z = 50 \text{ mA}$
Z-Widerstand	r_Z	52	60	67	75 Ohm	$I_Z = 50 \text{ mA}$
Z-Spannungs- toleranz	ΔU_Z	± 15	± 15	± 15	$\pm 15 \%$	$I_Z = 50 \text{ mA}$
Temperatur- koeffizient der Z-Span- nung	TKU_Z	0,18	0,18	0,18	0,18 %/K	

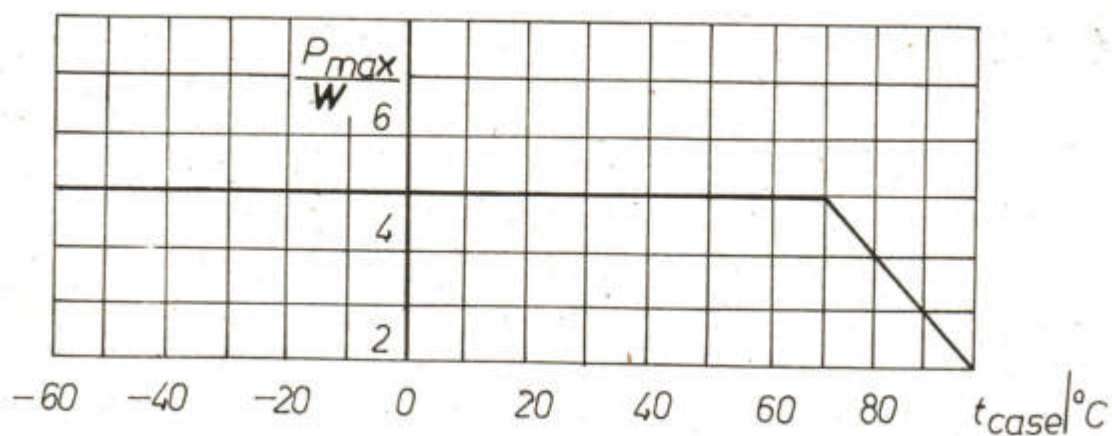


Bild 2: Abhängigkeit der Grenzverlustleistung der Z-Dioden von der Gehäusetemperatur t_{case}

Anwendungs- und Betriebshinweise

In allen Betriebsfällen muß unbedingt eine Gehäusetemperatur von maximal 100 °C gewährleistet sein. Bei der Montage der Z-Dioden dürfen am oberen Anschluß Kräfte von maximal 0,1 kp angreifen.

Bei der Befestigung der Z-Diode auf dem Kühlkörper muß die Zugkraft im Bereich von 7 - 10 kp liegen.

Beim Löten der Befestigung der Anschlußleitungen am oberen Anschluß muß die Löttemperatur im Bereich von 250 ± 10 °C liegen und die Löt-dauer darf 3 s nicht überschreiten.

Literatur

- /1/ Polupravednikovye diody Katalog Cast' 1 (Halbleiterdioden
Katalog Teil 1), 1979, Elorg Moskva, S. 142

Die vorliegenden Datenblätter dienen ausschließlich der Information! Es können daraus keine Liefermöglichkeiten oder Produktionsverbindlichkeiten abgeleitet werden. Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts sind vorbehalten.

RFT

Herausgeber:

veb applikationszentrum elektronik berlin
im veb kombinat mikroelektronik
DDR-1035 Berlin, Mainzer Straße 25
Telefon: 5 80 05 21, Telex: 011 2981; 011 3055